

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: **Instytut Technologii Elektronowej**

MIASTO: **Warszawa**

STANOWISKO: **Adiunkt**

DYSCYPLINA NAUKOWA: **elektronika**

DATA OGŁOSZENIA: **01.02.2019 r.**

TERMIN SKŁADANIA OFERT: **1.03.2019 r.**

LINK DO STRONY: **<http://www.ite.waw.pl>**

SŁOWA KLUCZOWE: **przrządy półprzewodnikowe, półprzewodniki szerokokoprzzerwowe, implantacja jonów**

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Zakres wykonywanych zadań:

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta będzie się zajmowała prowadzeniem badań i opracowaniem technologii wytwarzania przrządów na bazie półprzewodników tlenkowych dla elektroniki przezroczystej i elastycznej oraz technik sensorowych. Prace badawcze będą wykonywane w Zakładzie Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokokoprzerwowych.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku adiunkta w ww. zakładzie będzie należało:

- rozwój technik RBS/c do pomiaru składu atomowego cienkich warstw a także do analizy struktury krystalograficznej półprzewodników,
- prowadzenie prac badawczych nad modyfikacją właściwości półprzewodników poprzez implantację jonową:
 - a) w celu domieszkowania obszarów czynnych,
 - b) w celu izolacji elektrycznej obszarów czynnych,
 - c) w celu wytworzenia zdefektowanej warstwy zagrzebanej,
- prezentowanie wyników prac badawczych na forum lokalnym oraz międzynarodowym (raporty, seminaria, prezentacje konferencyjne oraz publikacje w czasopiśmie międzynarodowych i branżowych i materiałach konferencyjnych,
- pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie badań poprzez przygotowanie wniosków o finansowanie projektów i realizację usług naukowych.

Oczekiwania wobec kandydata:

- stopień doktora w dziedzinie fizyki lub nauk technicznych,
- ogólna znajomość zagadnień i wyzwań współczesnej fizyki i technologii półprzewodników,
- umiejętność posługiwania się akceleratorem typu tandem jako źródłem jonów do zastosowań analitycznych oraz jako generatorem ciężkich jonów do implantacji wysokoenergetycznej,
- umiejętność interpretacji widm RBS/c, także przy pomocy programów symulacyjnych SIMNRA i Mc Chasy,
- doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie modyfikacji właściwości materiałów na drodze implantacji jonów,
- umiejętność i uprawnienia do obsługi akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów potwierdzone stosownymi uprawnieniami.
- doświadczenie w kierowaniu projektami finansowanymi z zewnętrznych źródeł;
- doświadczenie zdobyte w ośrodkach zagranicznych,
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, drugi język będzie dodatkowym atutem,

Wymagane dokumenty:

- podanie,
- CV
- plan rozwoju kariery naukowej,
- dyplom (odpis lub kopia z poświadczeniem za zgodność z oryginałem) uzyskania stopnia doktora,
- spis osiągnięć naukowo-badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji, patentów i udziału w projektach naukowo-badawczych,
- opinia dwóch pracowników naukowych posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego,
- uprawnienia do pracy na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej „operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów” wydane lub zaakceptowane przez Prezesa PAA,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu.

Tryb i termin składania ofert:

Wyżej wymienione dokumenty prosimy składać w Sekretariacie Naukowym Instytutu (02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46, blok VI, pok. 107) do dnia **1.03.2019 r.** Pragniemy poinformować kandydatów, że komisja konkursowa może poprosić ich o publiczne przedstawienie wyników swoich prac naukowych w formie seminarium.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia **8.03.2019 r.**

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Instytucie Technologii Elektronowej.

Zgodnie z artykułami 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

- 1) administratorem danych osobowych jest Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie, ul. Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;
- 2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@ite.waw.pl;
- 3) dane osobowe kontrahentów, współpracowników, pracowników i byłych pracowników przetwarzane są wyłącznie na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów krajowych;
- 4) zakres oraz okres przetwarzania danych osobowych jest regulowany przepisami prawa;
- 5) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w oparciu o wymogi prawne lub dla realizacji celu, w jakim zostały zebrane;
- 6) dane osobowe przetwarzane w Instytucie Technologii Elektronowej nie podlegają profilowaniu;
- 7) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
- 8) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych;